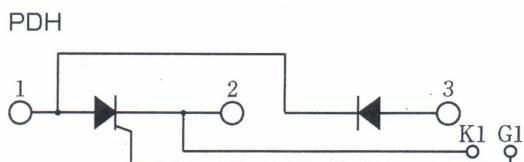
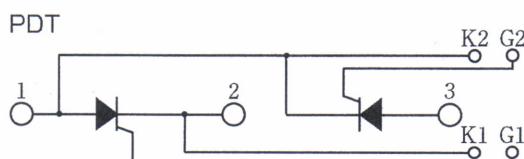


THYRISTOR

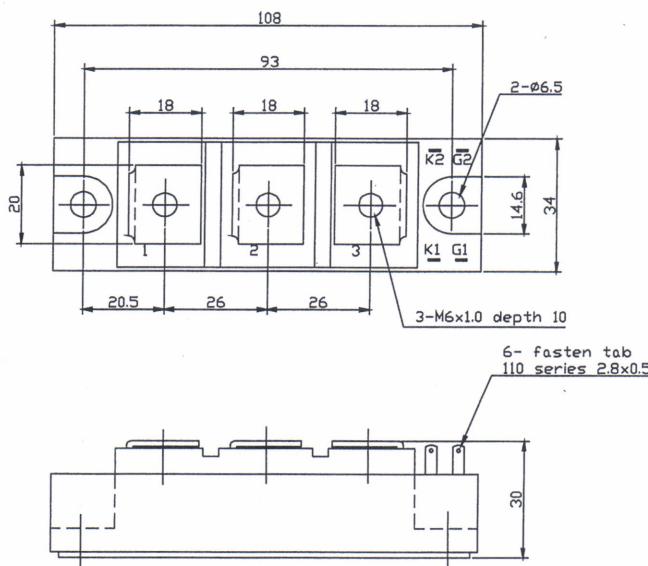
200A Avg 1600 Volts

PDT20116
PDH20116

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PDT20116/PDH20116		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	VDRM	1600		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	VDSM	1700		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	VRRM	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	VRSM	1700		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I _o (AV)	商用周波数 180° 通電 Half Sine Wave	200	A
実効オン電流 RMS On-State Current	I _r (RMS)		314	A
サーボン電流 Surge On-State Current	I _{tsm}	50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2 ~ 10ms	80000	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V _D =2/3V _{DRM} , I _{Tm} =2·I _o , T _j =125°C I _G =300mA, di/dt=0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	PGM		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	PG(AV)		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	IGM		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	VRGM		5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}		-40 ~ +125	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}		-40 ~ +125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V _{iso}	端子 - 裏面ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2500	V
締付トルク Mounting Torque	F _w	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6 2.5~3.5	N·m
主端子部 Terminal			M6 2.5~3.5	N·m

1 アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	IDM	T _j =125°C, V _{DM} =V _{DRM}			80	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	IRM	T _j =125°C, V _{RM} =V _{RRM}			80	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _j =25°C, I _{TM} =600A			1.4	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	IGT	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C		300	mA
			T _j = 25°C		150	mA
			T _j = 125°C		80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C		5	V
			T _j = 25°C		3	V
			T _j = 125°C		2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM}		0.25		V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dV/dt	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM}		500		V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j =125°C, I _{TM} =I _O , V _D =2/3V _{DRM} dV/dt=20V/μs, V _R =100V, -di/dt=20A/μs			100	μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}				6	μs
遅れ時間 Delay Time	t _d	T _j =25°C, V _D =2/3V _{DRM} I _G =300mA, dI _G /dt=0.2A/μs			2	μs
立上がり時間 Rise Time	t _r				4	μs
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25°C		100		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25°C		60		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間 Junction to Case,			0.2	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.1	°C/W

質量…約280g

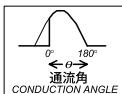
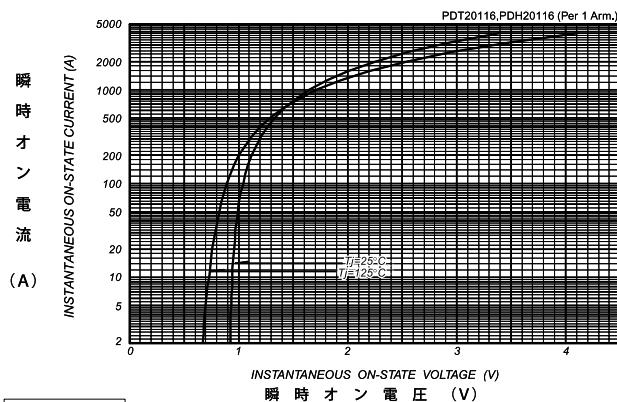
Approximate Weight

1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

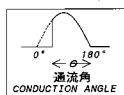
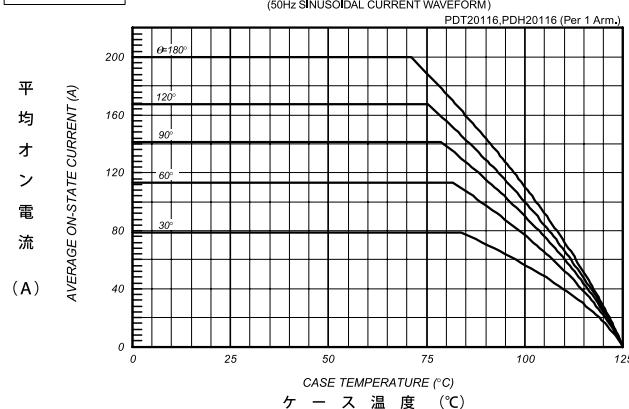
ナショナル半導体による

■定格・特性曲線

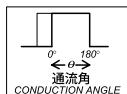
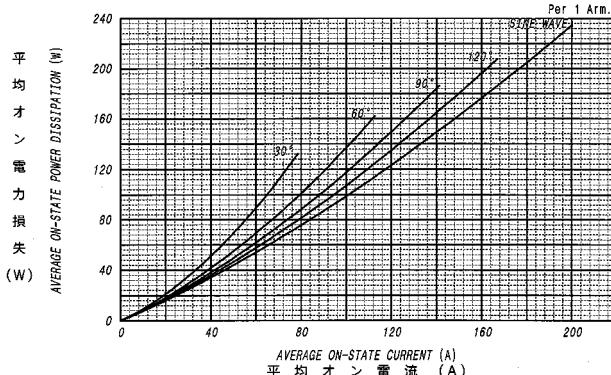
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



平均オン電流-ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
(50Hz SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM)



平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
FOR SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM



平均オン電流-ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
(50Hz RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM)

